加速 AI普及 ！美光領先業界的 HBM3E 解決方案正式量產

February 27, 2024 at 10:00 AM CST

相較於其他競品 美光 HBM3E 功耗降低約 30%

有助減少資料中心營運成本

2024 年 2 月 27 日，愛達荷州博伊西 — -全球記憶體和儲存解決方案的領導廠商美光科技（Nasdaq：MU），今宣布其 8 層堆疊 24GB HBM3E解決方案已正式量產。美光 HBM3E 解決方案將應用於輝達 H200 Tensor Core GPU，預計於 2024 年第二季出貨。此里程碑使美光穩居業界領先地位，憑藉 HBM3E 卓越的效能和能源效率，助益 AI 解決方案。

HBM3E: 推動 AI 革命

隨著 AI 需求不斷提升，能夠應付與日俱增工作負載的記憶體解決方案變得更加關鍵。美光 HBM3E 解決方案具備以下優勢應對此一挑戰：

- **卓越效能：** 美光 HBM3E 每腳位傳輸速率超過 9.2 Gb/s，記憶體頻寬達 1.2 TB/s 以上，為 AI 加速器、超級電腦與資料中心提供如閃電般快速的資料存取速度。
- **優異效率：** 與競品相比，美光 HBM3E功耗降低了約 30%，引領業界。為了支援日益增長的 AI 需求和應用，HBM3E 能以最低的功耗提供最大的傳輸量，進而改善資料中心重要的營運成本指標。
- **高可擴展性：** 美光 HBM3E 目前提供 24 GB 容量，使資料中心可無縫擴展其 AI 應用，無論是用於訓練大型神經網路還是加速推理任務，美光解決方案都能為其提供所需的記憶體頻寬。

美光執行副總裁暨事業長 Sumit Sadana 表示：「美光在 HBM3E 此一里程碑上取得了三連勝：領先的上市時間、業界最佳的效能、傑出的能源效率。AI 工作負載亟需記憶體頻寬與容量，美光 HBM3E 和 HBM4 產品藍圖領先業界，針對 AI 應用提供完整的 DRAM 和 NAND 解決方案，支援未來 AI 顯著的成長。」

透過其 1β 技術、先進直通矽晶穿孔 (TSV) 和其他創新，美光得以發展領先業界的 HBM3E 設計，並實現具差異性的封裝解決方案。作為記憶體領域中 2.5D/3D 堆疊和先進封裝技術的領導者，美光相當自豪成為台積電 3DFabric 聯盟的合作夥伴，共同形塑半導體和系統創新的未來。

美光也規劃將在2024 年 3 月推出 12 層堆疊 36GB HBM3E 的樣品，相較於競品，效能可達 1.2TB/s 以上並具備優異的能源效率，能進一步延續其業界領導地位。此外，美光也將成為輝達 GTC AI 大會的贊助商，該大會將於 3 月 18 日開始，屆時美光將更詳細地分享其領先業界的 AI 記憶體產品組合與藍圖。

關於 Micron Technology, Inc.

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界領導者，正在改變世界使用資訊的方式，豐富*所有人*的生活樣貌。美光持續關注於客戶、技術領導，以及製造和營運卓越，透過美光（Micron®）和 Crucial® 品牌提供高效能 DRAM、NAND 和 NOR 記憶體以及儲存空間產品的豐富產品組合。每一天，我們人員提出的創新推動了資料經濟、人工智慧和 5G 應用程式的進步，激發各種機會— 從資料中心到智慧邊緣以及客戶端和行動裝置使用者體驗。欲進一步瞭解 Micron Technology, Inc.（Nasdaq: MU），請瀏覽 micron.com。

© 2024 Micron Technology, Inc. 保留所有權利。資訊、產品和 / 或規格若有變動，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。

美光媒體關係聯絡人

Kelly Sasso
Micron Technology, Inc.
+1（208）340-2410

ksasso@micron.com

美光投資者關係聯絡人
Satya Kumar

Micron Technology, Inc.
+1（408）450-6199

satyakumar@micron.com